

H24 年 1 月 25 日

委員各位

日本学術振興会
結晶加工と評価技術第 145 委員会
委員長 田島 道夫

(独) 日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第 145 委員会
第 129 回研究会 開催通知

日時：2012 年 2 月 27 日 (月) 13:00 ~ 17:05

会場： 明治大学 駿河台キャンパス 大学会館 3 階 第 1・2 会議室

http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html

東京都千代田区神田駿河台 1-1 (TEL 03-3296-4545)

JR 中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線／御茶ノ水駅 下車徒歩 3 分

東京メトロ千代田線／新御茶ノ水駅 下車徒歩 5 分

都営地下鉄三田線・新宿線、東京メトロ半蔵門線／神保町駅 下車徒歩 5 分

テーマ 「窒化物バルク結晶の成長と評価 - 現状と今後の課題 -」

世話人： 上田 修 (金沢工業大学)、奥村次徳 (首都大学東京)、和田一実 (東京大学)、
酒井 朗 (大阪大学)

プログラム

- 13:00~13:05 開会の挨拶 田島道夫 (宇宙科学研)
- 13:05~13:10 はじめに 上田 修 (金沢工業大学)
- 13:10~14:00 「総論：GaN 系バルク結晶成長における課題と今後の展開」
碓井彰 (古河機械金属)
- 14:00~14:40 「アモノサーマル法による GaN 成長と課題」
横山千昭 (東北大)
- 14:40~15:20 「HVPE 法による AlN 厚膜成長と転位密度の低減技術」
三宅秀人、平松和政 (三重大学)
- 15:20~15:40 休憩
- 15:40~16:20 「MOVPE 法による大口径 GaN on Si 基板の開発」
小宮山 純 (コバレントマテリアル)
- 16:20~17:00 「Na フラックス法によるバルク GaN 結晶成長技術」
森 勇介 (大阪大)
- 17:00~17:05 おわりに 酒井 朗 (大阪大学)
- 17:05~17:30 総会
- 17:40~19:30 懇親会 (場所： リバティータワー23 階 宮城浩蔵ホール [旧サロン紫紺])

以上